This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PAT-NO:

JP403116910A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03116910 A

TITLE:

MAGNETIC ALLOY FILM

PUBN-DATE:

May 17, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

WATANABE, YASUSHI

INT-CL (IPC): H01F010/14, G11B005/31, H01F010/18

ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce magnetostriction by a method wherein the title magnetic alloy film is formed in multilayer structure of an Fe-M-O-N alloy and an Fe-M-O alloy.

CONSTITUTION: The title magnetic alloy film is formed in multilayer structure of Fe-M-O-N alloy and Fe-M-O alloy. The M of the above-mentioned alloys indicates an element containing at least one or more kinds of the group consisting of Ta, Nb and Si. As a result, the thermal stability of Bs and Hc denotes excellent characteristics equal to that of the former alloy single layer, and as magnetostriction becomes the value almost approximate to the average value of the magnetostriction of both alloys, a magnetic alloy of low magnetostriction can be obtained. Accordingly, when the above-mentioned magnetic alloy film is used, an excellent magnetic record reproducing can be conducted on a high coercive force medium, a highly efficient thin film magnetic head and the like can be manufactured, and high density magnetic record reproduction can also be accomplished.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO& Japio

® 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-116910

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)5月17日

H 01 F 10/14 G 11 B 5/31 H 01 F 10/18 9057-5E C 7426-5D 9057-5E

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

公発明の名称 磁性合金膜

②特 頭 平1-256112

20出 願 平1(1989)9月29日

@発明者 渡辺

表 志

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 日本ピクタ

-株式会社内

の出 願 人 日本ピクター株式会社

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地

明期普

1. 発明の名称

磁性合金膜

2. 特許請求の範囲

(1) Fe-M-O-N合金と、Fe-M-O合金との多層構造よりなる磁性合金膜。(但し、MはTa、Nb、Siからなる群の少なくとも1種以上の元素)

(2) Few Mx Oy Nz なる組成式で表され w x y z で示される原子%は

 $0.5 \le x \le 6 \qquad 0.1 \le y \le 20$

 $1 \le z \le 20$

w + x + y + z = 100

なる関係を有する合金と、

Fewl Mxl Oyl なる組成式で表され、wl xl yl で示される原子%は

 $0.5 \le x 1 \le 6$ $0.1 \le y 1 \le 20$

w1 + x1 + y1 = 100

なる関係式を有する合金とを交互に積層して多層 造としたことを特徴とする磁性合金膜。 (但し MはTa、Nb、Siからなる群の少なくとも1 種以上の元素)

(3) Few Mx Ov Nz なる合金と、Few 1 Mx 1 Ov 1 なる合金とを交互に積層した多層構造からなる磁性合金膜において、合金の膜厚方向の平均の組成 Few Mx Ov Nz が

 $0.5 \le \overline{X} \le 6 \qquad 0.1 \le \overline{y} \le 20$ $0.5 \le \overline{z} \le 15$

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、高密度磁気記録用の磁気ヘッドに適する磁性合金膜に関する。

(従来の技術)

近年、磁気記録の高密度化や広帯域化の必要性 が高まり、磁気記録媒体に高い抗磁力を有する。 性材料を使用して記録トラック 幅を狭くすること により、高密度磁気記録再生を実現している。 そ して、この高い抗磁力をもつ磁気記録媒体に記録 再生するするための磁気ヘッド材料として、飽和 磁東密度 B s の高い磁性合金が必要とされており、センダスト合金や C o - Z r 系非晶質合金等をコアの一部または全部に使用した磁気ヘッドが提案されている。

そして、センダスト合金やCo-Zr系非晶質合金よりも節和磁束密度の高い磁性合金として、 窒化鉄やFe-Si系合金等の鉄を主成分とした 磁性合金が知られている。

熱安定性にも優れていて、磁歪が非常に小さい磁 性合金膜を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

本発明は上記の課題を解決するためになされたものであり、Fe-M-O-N合金と、Fe-M-O-N合金と、Fe-M-O合金との多層構造よりなる磁性合金膜。(但し、MはTa、Nb、Siからなる群の少なくとも1種以上の元素)または

Few Mx O y N 2 なる組成式で表され w x y 2 で示される原子%は

 $0.5 \le x \le 6 \qquad 0.1 \le y \le 20$

 $1 \le z \le 20$

w + x + y + z = 100 なる関係を有する合金と、

Fewi Mx 1 Ovi なる組成式で表され、wl x 1 y 1 で示される原子%は

 $0.5 \le x \ 1 \le 6$ $0.1 \le y \ 1 \le 20$ $0.1 \le x \ 1 \le 1$

なる関係式を有する合金とを交互に積層して多層 構造としたことを特徴とする磁性合金膜。 (但し (発明が解決しようとする課題)

ところが、従来より知られている、これらの高 Bs磁性合金は保磁力Hcが大きく、そのままで は磁気ヘッドの材料としては不十分であるのでセンダスト合金やパーマロイ等の保磁力の小さい磁 性材料か、或いはSiO。等の非磁性材料を中間 層とした多層構造の磁気ヘッドが提案されている。

然しながら、このように異なる系の物質を多個化するには工数やコストがかかり、信頼性を保つのも難しいという問題点があった。

これらの問題点を解決するために、本発明人等はFe-N-O合金やFe-Ta-N-O合金等によって、多層構造にしない単層でも高飽和磁束密度を有しさらに低保磁力である磁性合金を提案した。(特願昭64-35071号明細書など)

ところで、磁気ヘッド等の磁性合金に要求される特性として、上記の他に磁歪がある。前記した Fe-Ta-N-O合金はすでに低磁歪を実現しているが、今後更に磁歪の低いものが必要となる可能生がある。本発明は飽和磁束密度Bsが高く

M は T a 、 N b 、 S i からなる群の少なくとも 1 種以上の元素)または

Few Mx Oy Nz なる合金と、Few 1 Mx 1 Oy 1 なる合金とを交互に積層した多層構造からなる磁性合金膜において、合金の膜厚方向の平均の組成 Few Mx Oy Nz が

 $0.5 \le \overline{X} \le 6 \qquad 0.1 \le \overline{y} \le 20$ $0.5 \le \overline{z} \le 15$

w + x + y + z = 100 である磁性合金膜をそれ ぞれ提供するものである。

(実施例)

本発明の磁性合金膜の製造装置の一実施例を第1

一対のターゲット 5 、 5 は鉄 (Fe) とタンタル (Ta) 、ニオブ (Nb) 、けい素 (Si) 等の添加元素の合金ターゲットか、或いは適当な凹部を設けた純鉄のターゲットの凹部にチップ状のTa、NbまたはSiをはめ込んだ複合ターゲットホトである。このターゲット 5 、 5 はターゲットルグ 9 によって支えられており、このターゲット

5 とターゲットホルダ9には、直流電源13よりマイナス電位が印加され、更にこのターゲットホルダ9の周囲にはシールド4 が取り付けてある。

又、このターゲットホルダ 9 の内部には、両ターゲット 5、5間にプラズマ 1 4 を収束するための破石 6、6 が挿入され、かつターゲット 5 の表面の加熱を防ぐために冷却水 8 が流入している。

をして、接地された真空槽15の左右に、2個のターゲットホルダ9が絶探体7によって絶録されて設けられている。

がターゲッツト5に衝突し、ターゲット5の鉄原 子及びTa、NbまたはSi等の原子が飛び出す。

そして、ターゲット 5 から飛び出したこれらの 原子とブラズマ中の酸素および窒素の原子 また た 分子が基板 1 1 の上に成長していく。 なお、スパッタ開始後の数分間は、シャッタ 1 0 を閉じま を取 1 1 を覆うことにより、ターゲット 5 のあ の不純物が基板 1 1 の上に付かないようにし、そ の後でシャッタ 1 0 を開けるようにする。

そして、流量計1~3にて酸素、窒素、アルゴンの導入量を調整すると共に、バルブa、bの開閉のタイミングを決めることにより、所望の元素組成比及び所望の膜厚のFew Mx Ov Nz とFew 1 Mx 1 Ov 1 との多層膜を得ることができる。(但し、MはTa、Nb、Siの内の少なくとも1種以上の元素)

このようにして得たFew Mx Ov Nz とFew I Mx I Ov I との多層膜の飽和磁束密度 Bs、保磁力 H.c、磁歪 λs を第 2 図に示す。又、比較のために Few Mx Ov Nz 単層および Few I

タリポンプ16に統いている。

真空楕内に窒素を導入する時はaが閉、bが閉になっており窒素は真空槽内に導入される。

室素を真空槽内に導入しない時は a が 閉、 b が 閉にっており窒素はロータリポンプ 1 6 によって 排気される。この時、真空槽内の圧力とロータリポンプ 1 6 の圧力を略同じにすることによって、 窒素の切り換え時の液量及び真空槽内の圧力変動を最小限に押さえることができる。

なお、アルゴンはターゲット 5 をスパッタする と同時に成膜する磁性合金膜中の酸素と窒素の量 を調節するためのものである。

そして、真空槽15の下部には基板ホルダ12 上に基板11が置かれ、不純物を防ぐためのシャッタ10が基板11を扱っている。

このようなスパッタ装置において、直流電源 13により、左右のターゲットホルダ9に支えられたターゲット5、5の間にプラズマ14を発生させると、ターゲット5はマイナス電位であるので、プラズマ14中のアルゴンイオン(Ar)

M x 1 O y 1 単層の場合の数値も記す。各数値は 300 ° c 以上の熱処理を行った後の値である。

この第2図から理解できるように、Fewll Mxl Ovl 単層では強症は負であり保証力は配では の Oeである。又、Few Mx Oy Nz 単層では Mx Oy 単層よりもいい。 更に、Few Mx Oy Nz の方がFew l Mx l Oy l よりでは 定性に優れていることを本発のなりまで。 を性いる。単層ではとのようなりまでをでいる。以上の水発でをでする。以上の水発でをでする。以上の水が、では、大変ではです。 Mx Oy Nz とFew l Mx l Oy l と定性を W Mx Oy Nz とFew l Mx l Oy l と定性を W Mx Oy Nz とFew l Mx l Oy l と定性を W Mx Oy Nz とFew l Mx l Oy l とだけを W Mx Oy Nz 単層の でを W Mx Oy Nz 単層の できる。 は Mx Oy Nz 単層の できる。 は Mx Oy Nz 単層の できる。

すなわち、Fe-M-N-O合金と、Fe-M-O合金との多層構造よりなる磁性合金膜、及び、Few Mx Ov Nz なる組成式で表されwxyzで示される原子%は

 $0.5 \le x \le 6$ $0.1 \le y \le 20$

 $1 \le z \le 20$

w + x + y + z = 100

なる関係式を有する合金と、

Fewl Mx I Oy I なる組成式で表され、

v 1 x 1 y 1 で示される原子%は

 $0.5 \leq x1 \leq \theta \qquad 0.1 \leq y1 \leq 20$

v1 + x1 + y1 - 100

なる関係式有する合金とを交互に積層して多層構造とした磁性合金膜、さらには、Few Mェ OァNz なる合金と、Few 1 Mェ 1 Ov 1 なる合金とを交互に積層した多層構造からなる磁性合金膜において、合金の膜厚方向の平均の組成Few Mェ Oァ Nェが

 $0.5 \le \overline{x} \le 8 \qquad 0.1 \le \overline{y} \le 20$ $0.5 \le \overline{z} \le 15$

マ + x + y + z = 100 である磁性合金膜によれば飽和磁束密度、保磁力、熱安定性に優れたものが得られると共に、磁歪に関しても所望の値のものが得られるものである。

起こり、特に本発明の目的の一つである高 B s を 達成できなくなる。 従って、空業の召有 3 % で と しくは、 1 ~10 原子 3 % で と しくは、 1 ~10 原子 3 % で と に も 優 で きる。 実験によれば T a が と を 得ることができる。実験によれば 有 が は 合金を 得ることができる。 な は 日 な の 内の 一種 以 上の 元素 の 合 財 な い な と と が 解った。 又、これらの 含 有 量 が 8 原子 3 % で 起 ことが 解った。 又、これらの 含 で ま で な と に は S i の 内の 一種 以 上の 元素 の 合計 合 ま た は S i の 内の 一種 以 上の 元素 の 合 計 会 ま た は S i の 内の 一種 と き 良 好 な 磁 気 特 性 と 熱 安 定 性 合金を 得ることができる。

Few Mx Oy Nz とFew 1 Mx 1 Oy 1 との多層膜の膜厚方向の平均の窒素含有量 Z は、Few Mx Oy Nz 中の窒素含有量 Z と、Few Mx Oy Nz の膜厚 t と Few 1 Mx 1 Oy 1 の膜厚 t 1 の比 t / t 1 によって決まるが、この膜厚方向の平均の窒素含有量 Z が 0.5 原子 %未満であると、十分な低日 c が得られず、とくに良好な熱

ここで、第3図としてFew Mェ Oァ Nェ なる 粗成式の合金の窒素およびTa、Nb、Siなど の添加元素の含有量と回転避場中で300° cの 処理を行なった後の飽和磁束密度(Bs)と保磁 力(Hc)との関係を示す。

なお、この図において含有量はESCA(X線 光電子分光分析法)EPMA(X線マイクロアナ ライザ法)等による定量分析で行い原子%で表し ている。保磁力は真空中での熱処理を行った時の 値であり熱処理温度は800 ° c である。

この図より明らかなように、酸素の含有量が 0.1 原子 % 未満であると十分な低日 c が 得られず、 20 原子 % を超えると 飲 磁気特性が 大 幅に 劣 化 し、 B s の低下と日 c の 増大が起こる。 従って、酸素の含有量が 0.1 ~ 20原子 %、 更に 好ましく は 0.1 ~ 10原子 % である時、 B s が高 含 有量 は、 1 原子 % 未満であると 十分な低日 c が 得 られず、 と く に良好な 熱安定性が得られない。 又、 窒素の 含有量 が 20原子 % を超えると B s の低下と日 c の 増大が

安定性が得られない。又、 z が 15% を超えると多層化したことによる磁亜の低下が顕著に現れなくなる。 従って、Few M z O v N z とFew 1 M x 1 O v 1 との多層膜の膜厚方向の平均の窒素含有量が 0.5 ~15原子%である時、 高Bs・低Hc・低磁速で熱安定性に優れた磁性合金を得ることができる。

(発明の効果)

記録再生が行える他、高性能の薄膜磁気ヘッド等を作成することも可能となり、高密度磁気記録再生が実現できる。

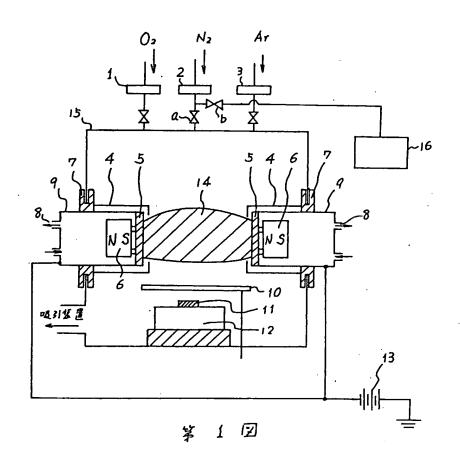
4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明になる磁性合金膜を製造する 装置の一実施例であるスパッタ装置の概略図、第 2図は、本発明になる多層構造からなる磁性合金 膜と単層構造の磁性合金膜との飽和磁束密度、保 磁力、磁歪、熱安定性のそれぞれの比較を示す図、 第3図は、FewMxOvNzなる組成式の合金 膜の窒素、酸素及びTa、Nb、Sitなどの添加 元素の含有量と飽和磁束密度、保磁力の関係を示す図である。

特許出願人	B	本	٢	2	9	-	抹	式:	会	扗
		tt	表	者		垣	木	i	邦	夫

	磁性合全膜	Bs(KG)	Hc(Oe)	λs	处在
本癸明の	Feat Ta3 O4 N5 /Feq3 Ta3 O4 時居体	17-5	0.2	8×10 ⁻⁷	0
磁性合	Fa 32 Nb 3 O4 N5 Fa 93 Nb 3 O4 符月 体	18	0.3	8×10 ⁻⁷	0
全膜	Fees St. 2 O 5 N 5 Fees St. 2 O 5 持居体	18	0. 1	6×10	0
	Feer Tas 04 Ns	17	0.2	3.5×10-6	0
比較	Fa 93 Ta3 04	18.5	. 1.0	-2×10 ⁻⁶	Δ
	Fa 88 Siz Os NS	ı 7.5	0.1	3×10-6	0
451	Fe 93 Si 2 O5	18	0.8	-2×10-6	×

第 2 回



言义**	0	N	Ta	Nb	Sı	Fe	Bs	НС
番号	(年3%)	(學多%)	(学3%)	(厚3%)	(原3%)		(KG)	(Oe)
1	3.8	4.1	1.8.	_		ba1.	17	0.2
2	4.5	3.6	_	1.5		ba1.	18	0.3
3	9.8	4.4	<i>3</i> . 8	-	_	bal.	15.5	0,8
4	2.5	19.3	1.0	-		bal.	10	1.0
5	19.4	<i>3</i> .7	1.1	-	-	bal.	11	1.0
6	2.6	3.7	-	_	2.0	bal.	17	0.1
7	0.1	9.6	-	_	1.5	bal.	15	0.5
8	9.8	1.0		-	6.0	ba1.	13	0.5
9	2.8	5.8		_	0.5	ba1.	17	0.3
10	2.5	19.3			1.5	ba1.	10	1.0
11	19.4	3.7	_		1.5	bal.	11	1.0

第 3 図

手続補正費



6. 補正の内容

平成元年11月1/4日

(1) 明細書第8頁第20行記載の「Ar」を

「Ar゚」と補正する。

(2) 同第10頁第16行記載の「10」を「10⁻⁶」 と補正する。

以上

特許庁長官 殿

事件の表示
平成1年特許願第256112号

2. 発明の名称

磁性合金膜

3. 植正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地

名称 (432) 日本ピクター株式会社

代表者 垣木 邦邦

4. 補正命令の日付 自発補正

5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の欄



方式 阅